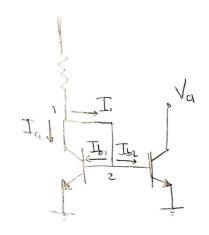
Espejos de cornente



Suponiendo que Qi es identico a Qz, Ib. = Ibz, \$ = \$z = \$, por lo

$$T_{ref} = T_{c1} + \frac{T_{c1}}{\beta} + \frac{T_{c1}}{\beta}$$

$$T_{ref} = T_{c1} \left(1 + \frac{2}{\beta}\right) : T_{c1} = T_{c2} = T_{0}$$

$$T_{0} = \frac{T_{ref}}{\left(1 + \frac{2}{\beta}\right)} : T_{ref} = \frac{V_{cc} - V_{1}}{P_{ref}}$$

Como Qi esta en saturación Vi = Vbe Por lo tunto:

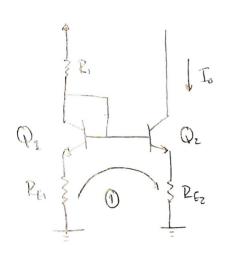
$$T_0 = \frac{V_{cc} - V_{be}}{\frac{\left(1 + \frac{2}{B}\right)}{B}}$$

Para generar una corriente de 20 mA, con una Pref = 1 Kr.
y un B=100

$$20mA = \frac{Vec - 0.7}{\left(1 + \frac{2}{100}\right) \cdot 1V}$$

$$20(1+\frac{2}{100}) = Vcc - 0.7$$

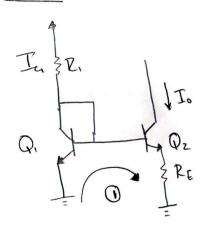
Podemos saber el valor necesario de Va con la diferencia de potencial Fuente de corriente simple con resistencia de emisor



Suponiendo que el transistor Q, es Bi, Bz = B Identicoo al transistor Q, o sea, Bi, Bz = B

Con $T_{e_1} = \frac{\sqrt{cc - \sqrt{8EI}}}{P_1 + P_{EI}}$

Fuente de corriente widlor:



Suponiendo que Qi es identico a Qz, B=Bz=3

Malla L

Teniendo que

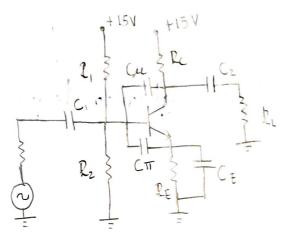
El Vbe tiene la signiente expresión. Vbe = Vt ln $\left(\frac{I_c}{I_s}\right)$ Sustituyendo la ecuación ① y teniendo en cuenta que los tran sistores son iguales $I_s = I_{si} = I_{sz}$.

-
$$V_{\tau} \ln \left(\frac{I_{cl}}{I_{s}} \right) + V_{\tau} \ln \left(\frac{I_{o}}{I_{s}} \right) + I_{o} R_{\varepsilon} = 0$$
 ②

Despejando To

$$T_0 \cdot R_E = V_T \ln \left(\frac{T_{CI}}{T_s}\right) - V_T \ln \left(\frac{T_0}{T_s}\right) = V_T \ln \left(\frac{T_{CI}}{T_0}\right)$$
 Por propiedades de Tendemos entonices que 1

Tarea: Diseñar un amplificador monoctapa emisor común con gandnerd Ava = 75+2 = 77



Suponemos

$$R_{1} = 60 \text{ KR}$$
 $R_{2} = 50 \text{ KR}$
 $R_{3} = 50 \text{ KR}$
 $R_{4} = 60 \text{ KR}$
 $R_{4} = 60 \text{ KR}$
 $R_{5} = 60 \text{ KR}$
 $R_{4} = 60 \text{ KR}$

$$V_A = 200V$$

$$I_C = 15 mA$$

$$77 = \frac{-\alpha Rc}{R_{E} + ree} = \frac{\frac{-\beta}{\beta+1}R_{c}}{\frac{r\pi}{\beta+1}} = \frac{-100Rc}{r\pi} = \frac{-100Rc}{166.7} = 77$$

$$\frac{166.7}{166.7}$$

$$r_0 = \frac{V_A}{T_c} = \frac{200V}{15mA} = 13.3KR$$

$$gm = \frac{I_c}{V_T} = 0.6 \frac{A}{V}$$

$$r_{\pi} = \frac{B}{9m} = \frac{100}{0.6} = 166.7 \Omega$$

Realicemos el analisis DC:

$$\begin{cases} 20 \text{ kg} & \text{ } \\ 20 \text{ kg} & \text{ } \\ 20 \text$$

$$R_{E} = \frac{2V}{15.15mA} = 132.0$$

Miremos que este en activo

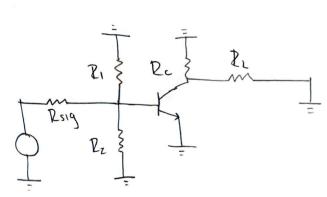
$$V_c = 13.08V$$

Encontremos:

V_{CE} = 11.07V ≥ 0.2V Vemos que cumple las condiciones. V_{BC} = -10.37 - Inverso para estar en activo

El transistor está en activo:

Señal:



Ahora hallemos los valores de los capacitores (Pava 20 Hz) Metodo de constantes de tiempo de corto-circuito

$$Z\pi(20H_z) = \frac{1}{185.7(C_1)}$$
; $C_1 = 42.9 \mu F$

$$2\pi (0.2 \text{Hz}) = \frac{1}{1.65(C_3)}$$
; $C_3 = 482.3 \text{mF}$

$$= 201 + 165.71 = 185.71$$

$$P_3 = P_E \left\| \left(\frac{1}{9m} \right) = 132 n \| 1.67 n \|$$

Haciendo uso de la tabla de formulas para calcular las resistencias.

Asumimos el primero como dominante y los demás para que fi no varie mucho

Por el metodo de constante de tiempo de circuito abierto.

R_π = γ_π || (P_B || P_S ||) = 166.72 || (21.3 × 2 || 200) = 166.72 || 19.99 2

Tendremos que hallar Pi, y Ro Haciendo uso de las formulas

$$P_{M} = 128 \times 1110 \times 1111 + (1+76.57)(165.7 \times 1110 \times 1111)$$

= 127.18 + 1384.3 = 1511.5 \text{ }

$$2\pi (100 \text{ KHz}) = \frac{1}{1511.5 \Omega(Cu)}$$
; $Cu = 1.05 \text{ nF}$

$$2\pi \left(150MH_{2}\right) = \frac{1}{11.85x(C_{\pi})}$$
; $C_{\pi} = 60pF$

Asumumos el primero como polo domunante y el segundo de tal manera que no afecte mucho el resultado de f.

resultante Circuito

